



第48回 薄膜・表面物理セミナー (2020)

ニューロデバイスに向けた最新メモリデバイス・薄膜材料技術

人間の脳の動作を模倣した、学習機能を有するニューロデバイスに関する研究が産官学で活発に進められています。ニューロデバイスの実現には、重み付け素子として高性能な不揮発性メモリを用いることが重要です。最先端のフラッシュメモリでは、微細化と3次元積層技術の進展により1Tbのメモリが実用化されるに至っていますが、さらなる高性能化を目的として、新しい動作原理や薄膜技術を用いた多様な新規不揮発性メモリの研究が盛んに行われています。本セミナーでは、ニューロデバイスへの応用を踏まえ、最先端の不揮発性メモリデバイスおよび薄膜材料技術について、第一線でご活躍されている講師の方々へ最新の成果をご紹介します。最新の研究動向を知りたい皆様や次世代を担う若手の皆様など多くの方々のご参加をお待ちしております。

日時:2020年7月10日(金) 10:00-16:30

場所:キャンパス・イノベーションセンター東京 (東京都港区芝浦3丁目3-6 TEL03-5440-9020)

<http://www.cictokyo.jp/access.html>

最寄り駅:JR田町駅(芝浦口徒歩1分)

1. プログラム:

(敬称略)

日時	講演テーマ	講師
10:00~10:10	開会	
10:10~10:55	不揮発性メモリを用いた AI プロセッサ/ニューロモルフィック回路技術の進展と今後の展望	森江 隆 (九工大)
10:55~11:40	Voltage-Control Spintronics Memory とその In-memory Computing への応用	與田 博明 (YODA-S 株式会社)
11:40~13:00	休憩	
13:00~13:45	強誘電体メモリトランジスタの基本とメモリ回路への応用	酒井 滋樹 (産総研)
13:45~14:30	不揮発性メモリを用いたアナログ抵抗変化制御の現状と課題	長谷川 剛 (早稲田大)
14:30~14:55	休憩	
14:55~15:40	相変化メモリ材料の研究開発動向	須藤 祐司 (東北大)
15:40~16:25	大容量化に向けた三次元フラッシュメモリセル技術	上牟田 雄一 (キオクシア)
16:25~16:30	閉会	

きます。 <http://www.jsap.or.jp/> より入会登録を行い、会費支払及び仮会員番号を取得後、本セミナーにお申込み下さい。(年会費をセミナー参加費と同時に振込なさらないで下さい。)

3. 定員:100名(満員になり次第締め切ります。)

4. 参加申込期間:2020年4月3日(金)~6月18日(木)

5. 参加申込方法:下記分科会ホームページ (<https://annex.jsap.or.jp/tfspd/>) 内の登録フォームにて参加登録してください。参加登録完了後、下記銀行口座に参加費をご連絡いただいた期日までにお振込ください。原則として参加費の払い戻し、請求書の発行は致しません。領収書は当日会場にてお渡しいたします。

6. 参加費振込期限:2020年6月26日(木)まで

7. 参加費振込先:

三井住友銀行 本店営業部 (本店でも可)
普通預金 口座番号: 9474715
(社) 応用物理学会薄膜・表面物理分科会
(シャ) 株式会社ツリカ ッカイハクマ・ヒョウメンツリブンカイ

8. 企画に関する問合せ先:

東レリサーチセンター 山元隆志
E-Mail: Takashi.Yamamoto@trc.toray.co.jp
東京工業大学 大見俊一郎
E-Mail: ohmi@ee.titech.ac.jp

9. 参加登録問合せ先:

応用物理学会事務局分科会担当 五十嵐周
TEL: 03-3828-7723 FAX: 03-3823-1810
E-Mail: igarashi@jsap.or.jp

2. 参加費: テキスト代、消費税を含む。

薄膜・表面物理分科会会員*	応用物理学会会員**・協賛学協会会員	学生	その他
10,000円	15,000円	3,000円	25,000円

*薄膜・表面物理分科会賛助会社の方は分科会会員扱いといたします。

**応用物理学会賛助会社の方は、応用物理学会会員扱いといたします。

現在非会員の方でも、参加登録時に薄膜・表面物理分科会(年会費正会員:2,200円(学生・院生:500円)、準会員:3,000円(学生・院生:500円))にご入会いただければ、本セミナーより会員扱いとさせていただきます。